

a 2015 0119

Invenția se referă la tehnica semiconductoare, și anume la procedeele de obținere a materialelor semiconductoare, în particular la creșterea monocristalelor de ZnO din faza gazoasă fără germene într-un volum închis.

Procedeul, conform invenției, constă în creșterea monocristalului de ZnO din faza gazoasă fără germene într-un volum închis la temperatura de 900...1100°C cu o diferență de temperatură dintre materialul de creștere și cristalul în creștere de 5...30°C, care se efectuează cu utilizarea agenților chimici de transport, așa ca HCl cu o presiune inițială la temperatura de creștere de 1...5 atm, carbon în proporție HCl:C = 2:(1...1,5) moli și hidro-gen, menținut în procesul de creștere la o presiune constantă egală cu 50...200% din presiunea inițială a HCl.

Revendicări: 1

Figuri: 4